



**ХII Конференция и XI Школа молодых ученых и  
специалистов  
по актуальным проблемам физики,  
материаловедения,  
технологии и диагностики кремния, нанометровых  
структур  
и приборов на его основе**

**Кремний 2018**

**ПРОГРАММА**

22-26 октября 2018 г., Черногоровка

## Организаторы:

Российская Академия наук  
Министерство науки и высшего образования РФ  
Научный Совет РАН по физике конденсированных сред  
Институт физики твердого тела РАН

Конференция проводится при финансовом содействии Российского Фонда  
Фундаментальных Исследований

## ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

### Председатели:

Кведер В. В. ИФТТ РАН, Черноголовка  
Левченко А.А. ИФТТ РАН, Черноголовка

### Зам. председателей:

Страумал Б.Б. ИЦЧ РАН, Черноголовка

### Члены программного комитета:

Абросимов Н.В. IKZ, Берлин  
Аристов Виталий Васильевич, ИПТМ РАН, Черноголовка  
Асеев А.Л. ИФП СО РАН, Новосибирск  
Брыкин А.В. ОАО «Росэлектроника»  
Волков Н.В. ИФ СО РАН, Красноярск  
Вяткин А.Ф. ИПТМ РАН, Черноголовка  
Горнев Евгений Сергеевич АО «НИИМЭ», Зеленоград  
Грибов Б.Г. ГНИИ ОСЧМ, Зеленоград  
Двуреченский А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск  
Егоров Е.П. ОАО ПХМЗ, Подольск  
Зайцев П.А. НИИ НПО «ЛУЧ», Подольск  
Исюк В.И. НЗПП с ОКБ, Новосибирск  
Казанский А.Г. МГУ, Москва  
Красильник З.Ф. ИФМ РАН, Н.Новгород  
Красников Г.Я. ОАО «НИИМЭ и Микрон», Москва  
Кудрявцева С. В. НИИ «Изотерм», Брянск  
Латышев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск  
Лукичев В.Ф. ФТИАН, Москва  
Неизвестный И.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск  
Непомнящих А..И. ИГХ СО РАН, Иркутск  
Никитов С.А. ИРЭ РАН, Москва  
Пархоменко Ю. Н. ГИРЕДМЕТ, Москва  
Попов В. П. ИФП СО РАН, Новосибирск  
Рощупкин Д.В. ИПТМ РАН, Черноголовка  
Саранин А.А. ИАПУ ДВО РАН, Владивосток  
Сауров А.Н. ИНМЭ РАН, Москва  
Сибельдин Н.Н. ФИАН, Москва  
Соболев Н.А. ФТИ РАН, С.-Петербург  
Сорокин Л.М. ФТИ РАН, С.-Петербург  
Теруков Е.И. ФТИ РАН, С.-Петербург

Чугуева И.Н. Министерство науки и высшего образования, Москва  
Якимов Е.Б. ИПТМ РАН, Черноголовка

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Кведер В. В. ИФТТ РАН, Черноголовка  
Левченко А.А.ИФТТ РАН, Черноголовка  
Страумал Б.Б. НЦЧ РАН, Черноголовка  
Терещенко Алексей Николаевич  
Хорошева Мария Анатольевна  
Горнакова Алена Сергеевна  
Когтенкова Ольга Александровна  
Сурсаева Вера Григорьевна  
Цой Кристина Валерьевна  
Страумал Александр Борисович  
Мазилкин Иван Андреевич

### *Адреса и контакты Программного комитета*

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела РАН, ул. Академика Ю.А. Осипяна, д.2, г.Черноголовка, 142432

Страумал Борис Борисович (зам. председателя оргкомитета)  
E-mail: [straumal@issp.ac.ru](mailto:straumal@issp.ac.ru)

Терещенко Алексей Николаевич (ученый секретарь)  
Тел. +7 49652 28201 (p), E-mail: [tan@issp.ac.ru](mailto:tan@issp.ac.ru)

Хорошева Мария Анатольевна (ученый секретарь)  
Тел.: +7 49652 28202 (p) E-mail: [khor@issp.ac.ru](mailto:khor@issp.ac.ru)

Горнакова Алена Сергеевна (оргвзнос и поселение)  
Тел.: +7 49652 28300 (p) E-mail: [alenahas@issp.ac.ru](mailto:alenahas@issp.ac.ru)

**Web-site:** <http://www.issp.ac.ru/ocs/index.php/issp/si2018>  
<http://mks-phys.ru/index.php/page/get/592>

# НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

## ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ

С 12<sup>00</sup> – регистрация участников Конференции и Школы молодых ученых в фойе пансионата «ДРУЖБА»

Экскурсия в ИФТТ РАН с 15.00

18:45 - Ужин

## **ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ**

**Конференц-зал пансионата «Дружба»**

**10:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ШКОЛЫ**

Вступительное слово. *А.А. Левченко, В.В. Кведер, Б.Б. Страумал*

**ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  
ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ФИЗИКИ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ,  
ТЕХНОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКИ КРЕМНИЯ, НАНОМЕТРОВЫХ СТРУКТУР И  
ПРИБОРОВ НА ЕГО ОСНОВЕ**

### 1-е заседание, Председатель –

- 10:25-11:00** **Е.С. Горнев** «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ», АО «НИИМЭ», Зеленоград (приглашенный)
- 11:00-11:35** **А.В. Двуреченский**, А.И.Якимов, А.Ф.Зиновьева, А.В.Ненашев, В.А.Зиновьев, А.А.Блошкин, В.В.Кириенко «ОПТИЧЕСКИЕ И СПИНОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ» ИФП СО РАН, Новосибирск (приглашенный)
- 11:35-11:55** **Т.В. Критская**, Шварцман Л.Я. «НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ «КРЕМНИЙ ИЗ ПЕСКА», Запорожская государственная инженерная академия, г. Запорожье, Украина
- 11:55-12:25** **КОФЕ-БРЕЙК**

## 2-е заседание, Председатель –

- 12:25-13:00** Ю.Н. Пархоменко, А.В.Наумов «НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ РЫНКА ПОЛИКРЕМНИЯ» АО "ГИРЕДМЕТ" (приглашенный)
- 13:00-13:35** Н.В. Абросимов «ИЗОТОПНО ЧИСТЫЙ КРЕМНИЙ – ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ, СВОЙСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ», IKZ, Берлин, ФРГ (приглашенный)
- 13:35-13:55** П.Г. Сенников, Буланов А.Д. «КРЕМНИЙ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА», *Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девярых РАН, Нижний Новгород*
- 14:00-15:00** ОБЕД

## 3-е заседание, Председатель –

- 15:00-15:35** Новиков А.В., Юрасов Д.В., Морозова Е.Е., Скороходов Е.В., Юнин П.А., Дроздов М.Н., Вербус В.А., Яблонский А.Н., Байдакова Н.А., Андреев Б.А., Бушуйкин П.А., Гусев Н.С., Кудрявцев К.Е «n-Ge/Si СЛОИ И ЛОКАЛЬНО РАСТЯНУТЫЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ДЛЯ КРЕМНИЕВОЙ ФОТониКИ», *Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород* (приглашенный)
- 15:35-16:10** Федина Л. И. «О ПРИРОДЕ ДИСЛОКАЦИОННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В Si: СТРУКТУРА ЯДРА И ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН* (приглашенный)
- 16:10-16:30** Соболев Н.А., Калядин А.Е., Шек Е.И., Вейко В.П., Поляков Д.С. «РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕМНИЕВЫХ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ СТРУКТУР С ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПРОТЯЖЕННЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ», *ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург*
- 16:30-16:50** Степихова М.В., Яблонский А.Н., Скороходов Е.В., Сергеев С.М., Шалеев М.В., Уткин Д.Е., Rutckaia V., Новиков А.В., Красильник З.Ф. «УСИЛЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ НАНООСТРОВКОВ Ge(Si) В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ РЕЗОНАТОРАХ НА БАЗЕ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ», *Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород*
- 16:50-17:10** Arutyunov N. Yu., Emtsev V. V., Krause-Rehberg R., Elsayed M., Oganessian G. A., Kozlovski V.V., Abrosimov N.V., «CONFIGURATION OF OPEN VACANCY VOLUME AROUND POSITRON IN n-TYPE FLOATING ZONE SILICON IRRADIATED BY 0.9-MeV

ELECTRONS», *Martin Luther University Halle, Department of Physics, 06120 Halle, Germany*

**17:10-17:40 КОФЕ-БРЕЙК**

**4-е заседание, Председатель –**

**17:40-18:00** **Паринова Е.В.**, Сиваков В., Чувенкова О.А., Коюда Д.А., Шлейзенер А., Овсянников Р., Марченко Д., Пислярук А.К., Турищев С.Ю. «АТОМНОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ НАНОСТРУКТУР НИТЕВИДНЫЙ КРЕМНИЙ - МОСVD ПОКРЫТИЕ SNO<sub>2</sub>», *Воронежский государственный университет, Воронеж*

**18:00-18:20** **Абрамкин Д.С.**, Петрушков М. О., Емельянов Е.А., Путьто М.А., Семягин Б.Р., Есин М.Ю., Лошкарев И.Д., Гутаковский А.К., Преображенский В.В., Шамирзаев Т.С. «ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ В ШИРОКОЗОННЫХ МАТРИЦАХ ALAS И GAP, СФОРМИРОВАННЫЕ НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ», *Институт физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск*

**18:20-18:40** **Страумал Б.Б.**, Мазилкин А.А., Когтенкова О.А., Горнакова А.С., Кильмаметов А.Р. «ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КРУЧЕНИЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ», *Институт физики твердого тела РАН, Черногловка*

**18:45 УЖИН**

**19:30 КОНЦЕРТ**

**СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ**

**Конференц-зал пансионата «Дружба»**

**НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ФИЗИКИ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ,  
ТЕХНОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКИ КРЕМНИЯ, НАНОМЕТРОВЫХ СТРУКТУР И  
ПРИБОРОВ НА ЕГО ОСНОВЕ**

**1-е заседание, Председатель –**

**Материаловедение кристаллического кремния: получение и очистка металлургического кремния, процессы роста из расплавов, химического осаждения из газовой фазы, аппаратура для роста; моделирование процессов роста.**

**10:00-10:20** Карабанов С.М., Суворов Д.В., Тарабрин Д.Ю., **Беляков О.А.**, Карабанов А.С., Сливкин Е.В., Серебряков А.Е., Трубицын А.А., Воронина Т.Н., Панов А.А., Ерахтин О.В. «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОГО РАФИНИРОВАНИЯ РАСПЛАВА КРЕМНИЯ В УСЛОВИЯХ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ», *Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань*

**10:20-10:40** **Гоник М. А.**, Florin Baltaretu, «HOW TO REACH A UNIFORM LONGITUDINAL IMPURITY DISTRIBUTION IN THE mc-Si INGOT», *ООО "ЦМ "Фотон", Александров*

**10:40-11:00** **Стенин В.В.**, Стенина Н.А. «РАФИНИРОВАНИЕ КРЕМНИЯ», *МЭИ, Москва*

**11:00-11:20** **Таланин В.И.**, Таланин И.Е., «ОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ», *Институт экономики и информационных технологий, Запорожье, Украина*

**11:20-11:40** **Наумова О.В.**, Нелюбин И.В., Фомин Б.И., Михайловский И.Г., Гаврилова Т.А. «ВЛИЯНИЕ H<sub>2</sub>/N<sub>2</sub> ПЛАЗМЫ НА ВЫСОТУ БАРЬЕРА МЕЖЗЕРЕННЫХ ГРАНИЦ LPCVD ПЛЕНОК ПОЛИ-КРЕМНИЯ», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*

**11:40-12:10** **КОФЕ-БРЕЙК**

**2-е заседание, Председатель –**

**Получение кремния солнечного качества и проблемы солнечной энергетики**

**12:10-12:30** Николаев В.И., Шпейзман В.В., Бобыль А.В., Кардашев Б.К., Бойко М.Е., Вербицкий В.Н., Теруков Е.И., Смирнова Е.В., Давитадзе С.Т. «ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОДЛОЖЕК КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ», *Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург*

**12:30-12:50** Байдакова Н.А., Вербус В.А., Морозова Е.Е., Новиков А.В., Скороходов Е.В., Шалеев М.В., Юрасов Д.В., Ota Y., Hombe A., Kurokawa Y., Usami N. «СОЗДАНИЕ BLACK-Si ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА СЧЕТ СЕЛЕКТИВНОГО ТРАВЛЕНИЯ СТРУКТУР С GeSi ОСТРОВКАМИ», *ИФМ РАН, Нижний Новгород*

**12:50-13:10** Писаренко Т.А., Балашев В.В., Викулов В.В., Димитриев А.А., Коробцов В.В. «ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>/SiO<sub>2</sub>/Si И Fe/SiO<sub>2</sub>/Si СТРУКТУРАХ», *ИАПУ ДВО РАН, Владивосток*

**13:10-13:30**

**13:30-13:50** Пещерова С.М., Непомнящих А.И., Чуешова А.Г., Клушина Н.В. «ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ЗЁРЕН В МУЛЬТИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КРЕМНИИ, ВЫРАЩЕННОМ МЕТОДОМ БРИДЖМЕНА», *Институт геохимии им. А.П. Виноградова, Иркутск*

**14:00-15:00** ОБЕД

### 3-е заседание, Председатель –

**Атомные процессы на поверхности, границах раздела и в объеме кремния: дефекты, примесные атомы, тонкие пленки – 1**

**15:00-15:20** Еременко В.Г., Rabier J. «АТОМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСЛОКАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ КРЕМНИЯ», *ИПТМ РАН, Черногловка*

**15:20-15:40** Кведер В.В., Хорошева М.А. «ВЛИЯНИЕ АТОМОВ ХРОМА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА КРЕМНИЯ С ДИСЛОКАЦИЯМИ И РОСТОВЫМИ ВАКАНСИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ», *ИФТТ РАН, Черногловка*

**15:40-16:00** Бондаренко А.С., Вывенко О.Ф. «ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ЛОВУШЕК НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДИСЛОКАЦИЙ», *Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург*



- 16:00-16:20** Ташметов М.Ю., Сулайманов Н.Т., Нормуродов А.Б., Махкамов Ш.М., Умарова Ф.Т., Хугаев А.В., Холмедов Х.М. «МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТНЫХ ЦЕНТРОВ УГЛЕРОДА В НАНОЧАСТИЦАХ КРЕМНИЯ», *Институт ядерной физики АН РУз, Ташкент, Узбекистан*
- 16:20-16:40** Орлов В.И., Ярыкин Н.А., Якимов Е.Б. «ВЛИЯНИЕ НИКЕЛЯ НА РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРОТЯЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ», *ИПТМ РАН, Черноголовка*
- 16:40-17:00** Орлов В.И., Солтанович О.А., Ярыкин Н.А., Якимов Е.Б. «ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НИКЕЛЯ С ПРОТЯЖЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ В КРЕМНИИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ МЕТОДОМ DLTS», *ИПТМ РАН, Черноголовка*
- 17:00-17:30** **КОФЕ-БРЕЙК**
- 17:30 – 18:45** **Стендовая сессия - 1**
- 18:45** **УЖИН**
- 19:30** **КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА**

## ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ

### Конференц-зал пансионата «Дружба»

#### 4-е заседание, Председатель –

**Атомные процессы на поверхности, границах раздела и в объеме кремния: дефекты, примесные атомы, тонкие пленки – 2**

- 10:00-10:20**      Вдовин В.И., «ДИСЛОКАЦИОННЫЕ ДИПОЛИ В ПРОЦЕССАХ ПЛАСТИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В Si», *Институт физики полупроводников, Новосибирск*
- 10:20-10:40**      Хорошева М. А., Кведер В. В., Терещенко А. Н. «ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА АТОМОВ ЖЕЛЕЗА НА ДИСЛОКАЦИЯХ В КРЕМНИИ», *ИФТТ РАН, Черноголовка*
- 10:40-11:00**      Yarykin N., Lastovskii S., Weber J. «EFFECT OF NICKEL IN-DIFFUSION ON THE VACANCY-TYPE DEFECTS IN SILICON», *Institute of Microelectronics Technology RAS, Chernogolovka*
- 11:00-11:20**      Ярыкин Н.А., Шуман В.Б., Порцель Л.М., Лодыгин А.Н., Астров Ю.А., Абросимов Н.В., Weber J. «ЕМКОСТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО МАГНИЕМ», *ИПТМ РАН, Черноголовка*
- 11:20-11:40**      Рогило Д. И., Пономарёв С. А., Федина Л. И., Щеглов Д. В., Латышев А. В., «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АДАТОМОВ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВАКАНСИЙ НА ЭКСТРЕМАЛЬНО ШИРОКИХ ТЕРРАСАХ ПОВЕРХНОСТИ Si(111) В ПРОЦЕССЕ СУБЛИМАЦИИ», *Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*
- 11:40-12:10**      **КОФЕ-БРЕЙК**

#### 5-е заседание, Председатель –

**Тонкие пленки в кремниевой микроэлектронике: эпитаксиальные слои, кремний-на-изоляторе, напряженные структуры и low и high-k диэлектрик**

- 12:10-12:30**      Родякина Е.Е., Ситников С.В., Латышев А.В. «ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАРЯД АДАТОМА НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ (001) В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОМИГРАЦИИ», *Институт физики*

*полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск*

**12:30-12:50** Терехов В.А., **Барков К.А.**, Коновалов А.В., Ивков С.А., Фоменко Ю.Л., Локтионова О.Е., Нестеров Д.Н., Домашевская Э.П. «ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАКИСИ АЗОТА В ГАЗОВОЙ СМЕСИ SiH<sub>4</sub>-N<sub>2</sub>O НА СООТНОШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И АМОРФНЫХ ФАЗ В ПЛЕНКАХ ПОЛУИЗОЛИРУЮЩЕГО КРЕМНИЯ», *Воронежский государственный университет, Воронеж*

**12:50-13:10** **Щукин В.Г.**, Константинов В.О., Шарафутдинов Р.Г. «СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК КРЕМНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫХ ГАЗОСТРУЙНЫМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ С ПАРАМЕТРАМИ ПЛАЗМЫ», *Институт Теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск*

**13:10-13:30** **Попов В.П.**, Антонов В.А., Ильницкий М.А., Гисматулин А.А. «КНИ СТРУКТУРЫ С УЛЬТРАТОНКИМИ СЛОЯМИ ДИОКСИДА ГАФНИЯ», *Институт физики полупроводников им.А.В. Ржанова, Новосибирск*

**13:30-13:50** **Зайцева Э. Г.**, Наумова О. В., Фомин Б. И. , «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ВБЛИЗИ ГЕТЕРОГРАНИЦ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ КРЕМНИЕВЫХ СТРУКТУР», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск*

**14:00-15:00** ОБЕД

#### **6-е заседание, Председатель –**

**Нанотехнологии кремниевой электроники, включая, ионную имплантацию, литографию, технологии создания квантовых структур, диагностики**

**15:00-15:20** **Терещенко А.Н.**, Королев Д.С., Никольская А.А., Михайлов А.Н., Белов А.И., Тетельбаум Д.И., Хорошева М.А., **Штейнман Э.А.** «ВЛИЯНИЕ ГЕТТЕРИРОВАНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ДИСЛОКАЦИОННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННОМ КРЕМНИИ», *ИФТТ РАН, Черноголовка*

**15:20-15:40** Махвиладзе Т.М., **Сарычев М.Е.**, «МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИШИНГ-ЭФФЕКТА ПРИ ПОЛИРОВАНИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР МЕДЬ - ДВУОКИСЬ КРЕМНИЯ», *Физико-технологический институт РАН, Москва*

**15:40-16:00** **Коюда Д.А.**, Турищев С.Ю., Терехов В.А., Паринаова Е.В., Грачев Д.А., Карабанова И.А., Ершов А.В., Машин А.И., Агапов Б.Л., Куликова

Т.В., Занин И.Е., Овсянников Р., Домашевская Э.П. «ЭВОЛЮЦИЯ АТОМНОГО, ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ И СОСТАВА МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ КРЕМНИЯ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ МОДИФИКАЦИИ», *Воронежский государственный университет, Воронеж*

**16:00-16:20**

**16:20-16:40**

**Королев Д.С.**, Никольская А.А., Михайлов А.Н., Белов А.И., Сушков А.А., Павлов Д.А., Тетельбаум Д.И. «ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ ФАЗ КРЕМНИЯ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ», *Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород*

**16:40-17:00**

**Баталов Р.И.**, Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Лядов Н.М., Хайбуллин Р.И., Базаров В.В., Гумаров А.И. «ОСОБЕНОСТИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛУЧЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛА Si ПУЧКОМ ИОНОВ He<sup>+</sup>», *Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН», Казань*

**17:00-17:30**

**КОФЕ-БРЕЙК**

**17:30 – 18:45**

**Стендовая сессия - 2**

**18:45**

**УЖИН**

**19:30**

**КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА**

## ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ

### Конференц-зал пансионата «Дружба»

#### 7-е заседание, Председатель –

Нанотехнологии кремниевой электроники, включая, ионную имплантацию, литографию, технологии создания квантовых структур, диагностики

- 10:00-10:20**      **Баранов Г.В.**, Итальянцев А.Г., Симакин С.Г. «ЭФФЕКТ ЗАТОРМОЖЕННОЙ ДИФФУЗИИ Sb ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ СТРУКТУРЫ SiO<sub>2</sub>-Si», АО «НИИМЭ», Зеленоград
- 10:20-10:40**      **Попов В.П.**, Сафронов Л.Н., Жанаев Э.Д., Антонов А.В. «ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ МНПВО НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИН КРЕМНИЯ ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННЫХ ОБРАБОТОК», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*
- 10:40-11:00**      **Воробьев В.В.**, Рогов А.М., Осин Ю.Н., Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Степанов А.Л. «РАСПЫЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНАМИ СЕРЕБРА», *Междисциплинарный центр Аналитическая микроскопия, КФУ, Казань*
- 11:00-11:20**      **Смагина Ж.В.**, Зиновьев В.А., Рудин С.А., Кривякин Г.К., Яблонский А.Н., Степихова М.В., Новиков А.В., Двуреченский А.В. «УПОРЯДОЧЕННЫЕ АНСАМБЛИ GeSi КВАНТОВЫХ ТОЧЕК НА СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ Si(100)», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*
- 11:20-11:40**      **Камаев Г.Н.**, Гридчин В.А., Неизвестный И.Г., Сабурова В.И., Черкаев А.С. «ВЛИЯНИЕ МАСШТАБИРОВАНИЯ НА ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛИКРЕМНИЕВЫХ МЕЗАРЕЗИСТОРОВ», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск*
- 11:40-12:10**      **КОФЕ-БРЕЙК**

#### 8-е заседание, Председатель –

Кремниевая электронная компонентная база для наноэлектроники, оптоэлектроники, силовой электроники, светоизлучающих структур, фотоприемников, микромеханики и сенсорики.

- 12:10-12:30**      **Ильницкий М.А.**, Попов В.П., Куприянов И.Н., Мяконьких А.А., Руденко К.В., Иванов Ю.Д., Мальсагова К.А., Плешакова Т.О., Арчаков А.И. «НАНОПРОВОЛОЧНЫЕ КНИ МОП ТРАНЗИСТОРЫ С Н-К СТЕКОМ ДЛЯ БИО- И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ»,

*Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,  
Новосибирск*

- 12:30-12:50**      **Барабаненков М.Ю.**, Барабаненков Ю.Н. «СРАВНЕНИЕ ВОЛНОВОДНЫХ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПОЧЕК Au И Si НАНОСФЕР», *ИПТМ РАН, Черноголовка*
- 12:50-13:10**      **Леонов А.В.**, Мордкович В.Н. «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КРЕМНИЕВЫХ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ ТОНКОПЛЁНОЧНОГО ДВУХЗАТВОРНОГО ТРАНЗИСТОРА СО ВСТРОЕННЫМ КАНАЛОМ В КАЧЕСТВЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА», *ИПТМ РАН, Черноголовка*
- 13:10-13:50**      **ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ**
- 14:00-15:00**      **ОБЕД**

## **Стендовая сессия - 1**

**24 октября, среда, 17:30**

- C1-1**      **Зиненко В.И.**, Агафонов Ю.А., Сарайкин В.В., Еременко В.Г., Седловец Д.М., Рошупкин Д.В. «СИНТЕЗ ПЛЕНОК SiC НА КРЕМНИИ ХОЛОДНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ АТОМОВ ОТДАЧИ УГЛЕРОДА», *ИПТМ РАН, Черноголовка*
- C1-2**      **Рысбаев А.С.**, Нормуродов М.Т., Бекпулатов И.Р., Игамов Б.Д. «ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК СИЛИЦИДОВ Rb и Li НА ПОВЕРХНОСТИ Si(111)», *Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ), Ташкент, Узбекистан*
- C1-3**      **Рысбаев А.С.**, Нормуродов М.Т., Хужаниязов Ж.Б., Камилов Т.С., Гаибов А.Г. «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СИЛИЦИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ», *Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ), Ташкент, Узбекистан*
- C1-4**      Alimov N., **Otajonov S.**, Tolanov O. «TEMPERATURE VARIATIONS OF TIME OF LIFE CARRIERS IN HETERO STRUCTURES p - CdTe - SiO<sub>2</sub>-Si WITH DEEP IMPURITY LEVELS», *Ферганский Государственный университет, Фергана, Узбекистан*
- C1-5**      **Сагдиев А.Р.**, Махкамов Ш., Ташметов М.Ю., Эрдонов М.Н., Холмедов Х.М. «ЛЕГИРОВАНИЕ КРЕМНИЕВЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ БЫСТРОДИФФУНДИРУЮЩИМИ

ПРИМЕСЯМИ», *Институт ядерной физики Академии наук  
Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан*

- C1-6**                    **Шенгуров В.Г.**, Денисов С.А., Чалков В.Ю., Прохоров Д.С., Зайцев А.В., Кудрин А.В., Здоровейщев А.В., Дорохин М.В., Бузынин Ю.Н., Трушин В.Н., Ведь М.В. «РОСТ МЕТОДОМ «ГОРЯЧЕЙ ПРОВОЛОКИ» СИЛЬНОЛЕГИРОВАННЫХ Ge/Si(001) СЛОЕВ N-ТИПА ПРОВОДИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GaP-ИСТОЧНИКА», *НИФТИ, Нижний Новгород*
- C1-7**                    **Денисов С.А.**, Чалков В.Ю., Шенгуров В.Г., Зайцев А.В., Кудрин А.В., Здоровейщев А.В. «ВЫРАЩИВАНИЕ МЕТОДОМ NW-CVD СЛОЕВ ГЕРМАНИЯ p-ТИПА ПРОВОДИМОСТИ С ВЫСОКОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ ДЫРОК НА КРЕМНИИ», *НИФТИ, Нижний Новгород*
- C1-8**                    Анфимов И.М., Варлачев В.А., Дробышевский Ю.В., **Кобелева С.П.**, Некрасов С.А., Прохоров А.К., Столюов С.Н., Щемеров И.В., Егоров Д.С. «КРЕМНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ КАК ДЕТЕКТОР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ В ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ», *НИТУ "МИСиС", Москва*
- C1-9**                    **Лозовой К.А.**, Коханенко А.П., Войцеховский А.В. «СИНТЕЗ ДВУМЕРНЫХ СТРУКТУР И КВАНТОВЫХ ТОЧЕК НА ПОВЕРХНОСТИ Si(111)», *Томский государственный университет, Томск*
- C1-10**                  Кобелева С.П., Латухина Н.В., **Рогожина Г.А.**, Щемеров И.В. «КОНТАКТНЫЕ И БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ», *Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, Самара*
- C1-11**                  Латухина Н.В., **Лизункова Д.А.**, Паранин В.Д., Казакевич П.В. «МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ С ПРОСВЕТЛЯЮЩИМИ ПОКРЫТИЯМИ», *Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, Самара*
- C1-12**                  Латухина Н.В., Лизункова Д.А., **Шишкин И.А.** «ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФЭП НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЛЕТНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА МКА "АИСТ-2Д"», *Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, Самара*

- C1-13** **Иванов В.М.** «СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ SiHCl<sub>3</sub> И SiCl<sub>4</sub>», ООО "Германий и приложения", Новомосковск
- C1-14** **Иванов В.М.** «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХЛОРИРОВАНИЯ В СОЛЕВОМ РАСПЛАВЕ», ООО "Германий и приложения", Новомосковск
- C1-15** **Аскарлов Ш.И.**, Шарипов Б.З., Салиева Ш.К., Шукурова Д.М. «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ДИФФУЗАНТА НА СОСТОЯНИЯ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ СЕРЫ В КРЕМНИИ», *Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан*
- C1-16** **Аскарлов Ш.И.**, Шарипов Б.З., Сражев С.Н., Тошбоев Т.У., Салиева Ш.К. «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ БЫСТРОДИФФУНДИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ГЕНЕРИРУЕМЫХ ТЕРМОДОНОРОВ В КРЕМНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 450°C», *Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан*
- C1-17** **Аношин К.Е.**, Алимов О.М., Гоник М.А., Наумов А.В. «МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ ГЕРМАНИЕВЫХ ОКОН», «ИнфраКристалл», *Лыткарино*
- C1-18** Аношин К.Е., Наумов А.В. **Смирнова Н.Н.** «ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКАНСИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ГЕРМАНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 мм», «ИнфраКристалл», *Лыткарино*
- C1-19** Черкова С.Г., Володин В.А., Скуратов В.А., **Камаев Г.Н.** «СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ GeO/SiO<sub>2</sub> ПРИ ОБЛУЧЕНИИ БЫСТРЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск*
- C1-20** **Павликов А. В.**, Латухина Н. В., Лизункова Д. А. «ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО НА ШЛИФОВАННЫХ ПЛАСТИНАХ», *МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва*
- C1-21** **Ярыкин Н.А.**, Агафонов Ю.А., Зиненко В.И. «ВЛИЯНИЕ КОИМПЛАНТАЦИИ ГЕЛИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ВВЕДЕНИЯ ВОДОРОДНЫХ ДОНОРОВ В КРЕМНИЙ», *ИПТМ РАН, Черноголовка*

- C1-22** Недомолкина А.А., Гутаковский А.К. «ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ GaSb НА ПОВЕРХНОСТИ Si(001)», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск*
- C1-23** Юрасов Д.В., Дроздов М.Н., Новиков А.В., Шмагин В.Б. «СЕГРЕГАЦИЯ ДОНОРОВ И АКЦЕПТОРОВ ПРИ ЭПИТАКСИАЛЬНОМ РОСТЕ SI И GE НА ПОДЛОЖКАХ РАЗЛИЧНОЙ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ», *Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород*
- C1-24** Рыгалин Б.Н., Прокофьева В.К., Никифоров М.О. «ВЛИЯНИЕ ВИДА ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЛОЖКИ НА СВОЙСТВА КРЕМНИЕВЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР», *Московский институт электронной техники, Москва*
- C1-25** Котерева Т. В., Сенников П. Г., Нежданов А. В., Буланов А. Д., Абросимов А. В. «ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ ИЗОТОПНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ Si<sup>11</sup>-xGe<sub>x</sub> (X=0,007)», *Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девярых Российской академии наук, Нижний Новгород*
- C1-26** Лошкарев И.Д., Петрушков М.О., Василенко А.П., Труханов Е.М., Пулято М.А., Преображенский В.В. «ФОРМИРОВАНИЕ СЕТКИ ДИСЛОКАЦИЙ НЕСООТВЕТСТВИЯ В СИСТЕМАХ GaSb/Si(001) С РАЗЛИЧНЫМИ ПОДСЛОЯМИ ЗАРОЖДЕНИЯ», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск*
- C1-27** F. Mosel, A.V. Denisov, B. Klipp, N. Sennova, M. Herms, R. Kunert, P. Dold «COST EFFECTIVE GROWTH OF SILICON MONO INGOTS BY THE APPLICATION OF THE MULTIPULLING TECHNIQUE COMBINED WITH ACTIVE CRYSTAL COOLING», *PVA Crystal Growing Systems GmbH, Wetztenberg, Germany*

**Стендовая сессия - 2**

**25 октября, четверг, 17:30**

- C2-1** Батаронов И.Л., Дежин В.В. «О КОЛЕБАНИЯХ ДИСЛОКАЦИИ В КРИСТАЛЛАХ С ВЫСОКИМ БАРЬЕРОМ ПАЙЕРЛСА», *Воронежский государственный технический университет, Воронеж*

- C2-2** Батаронов И.Л., Дежин В.В. «ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ РАДИАЦИОННЫМИ ПОТЕРЯМИ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ДИСЛОКАЦИИ В РЕЛЬЕФЕ ПАЙЕРЛСА», *Воронежский государственный технический университет, Воронеж*
- C2-3** Паринова Е.В., Сиваков В., Пислярук А.К., Коюда Д.А., Шлэйзенер А., Овсянников Р., Чувенкова О.А., Турищев С.Ю. «ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ НАНОПОРОШКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ МАССИВОВ НИТЕВИДНОГО КРЕМНИЯ», *ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", Воронеж*
- C2-4** Вerezуб Н.А., Простомолотов А.И. «ВЛИЯНИЕ РОСТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ПОВЕДЕНИЕ V-I ГРАНИЦЫ ПРИ РОСТЕ БЕЗДИСЛОКАЦИОННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ», *Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва*
- C2-5** Рогило Д. И., Федина Л. И., Щеглов Д. В., Латышев А. В. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ПУЧКА СЕЛЕНА С АТОМНО-ЧИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Si(111)», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск*
- C2-6** Рогило Д. И., Федина Л. И., Щеглов Д. В., Латышев А. В. «МНОГОСЛОЙНЫЙ РОСТ КРЕМНИЯ НА ЭКСТРЕМАЛЬНО ШИРОКИХ ТЕРРАСАХ ПОВЕРХНОСТИ Si(111) ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск*
- C2-7** Стук А.А., Стукова И.А., Стужнев Ю.А., Степанов В.И., Кочнов О.Ю. «ЯДЕРНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ КРЕМНИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЯЛК НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РЕАКТОРЕ ВВР-Ц», *АО "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова", Обнинск*
- C2-8** Брылевский В.И., Брунков П.Н., Гуткин А.А., Иванов М.С., Подольская Н.И., Смирнова И.А., Родин П.Б., Грехов И.В. «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРЕМНИЕВЫХ ДИОДНЫХ ОБОСТРИТЕЛЕЙ ПИКОСЕКУНДНОГО ДИАПАЗОНА», *Физико-технический Институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург*
- C2-9** Есин М.Ю., Никифоров А.И., Тимофеев А.А. «ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ

ВИЦИНАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Si(100)», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск*

- C2-10** Шуман В.Б., Лодыгин А.Н., Порцель Л.М., Абросимов Н.В., **Астров Ю.А.** «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИМЕСИ МАГНИЯ», *Физико-технический Институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург*
- C2-11** Садчиков А.С., Чувенкова О.А., Тонких А.А., Овсянников Р., Парина Е.В., **Коюда Д.А.**, Турищев С.Ю. «ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ НАНОСЛОЕВ ОЛОВА НА КРЕМНИИ ПРИ ИХ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ В ВАКУУМЕ», *ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет", Воронеж*
- C2-12** **Мамедов Ш.Г.**, Курбанова Р.Д., Мамедова Ф.М. «ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ Ag<sub>2</sub>SnS<sub>3</sub>-AgSbS<sub>2</sub>», *Институт катализа и неорганическая химии им.М Нагиева НАНА, Баку, Азербайджан*
- C2-13** **Жарова Ю. А.**, Толмачев В. А., Павлов С.И., Гущина Е.В. «ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТРОВКОВОЙ ПЛЕНКИ СЕРЕБРА И СЛОЯ КРЕМНИЕВЫХ НАНОНИТЕЙ НА МОРФОЛОГИЮ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА», *Физико-технический Институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург*
- C2-14** **Деточенко А. П.**, Ежевский А. А., Сухоруков А. В., Гусейнов Д. В., Конаков А. А., Денисов С. А., Чалков В. Ю., Шенгуров В. Г. «ТОНКИЕ СЛОИ КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННЫЕ ВИСМУТОМ, ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СПИНОВОГО ТРАНСПОРТА», *Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород*
- C2-15** **Данилов Д.В.**, Лошаченко А.С., Вывенко О.Ф. «РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРОГО ВОДОРОДА В ПРОЦЕССЕ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ КРЕМНИЯ», *Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург*
- C2-16** **Петров А.С.**, Рогило Д.И., Щеглов Д.В., Латышев А.В. «ВЛИЯНИЕ СТОКА АДАТОМОВ В СТУПЕНИ НА ДВУМЕРНО-ОСТРОВКОВОЕ ЗАРОЖДЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ Si(111)-(7×7) ПРИ ОСАЖДЕНИИ Si И Ge», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск*

- C2-17** **Гурьянов А.М.** «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ В КРЕМНИЕВЫХ МДП-СТРУКТУРАХ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЛОЯМИ ОКСИДА СКАНДИЯ», Самарский государственный технический университет, Самара
- C2-18** **Критская Т.В.**, Журавлёв В.Н. «ЭФФЕКТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ РАЗРУШЕНИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ», Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, Украина
- C2-19** **Паршин Е.О.**, Мелесов Н.С., Симакин С.Г, Калядин А.Е., Сахаров В.И., Серенков И.Т., Шек Е.И., Соболев Н.А. «ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОТЖИГА НА СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРЕМНИЯ, ИМПЛАНТИРОВАННОГО ИОНАМИ ГЕРМАНИЯ», Ярославский Филиал Физико-Технологического Института Российской Академии Наук, Ярославль
- C2-20** **Басалаева Л. С.**, Настаушев Ю. В., Дульцев Ф.Н. «ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИТОГРАФИИ НА НЕГАТИВНОМ РЕЗИСТЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УПОРЯДОЧЕННЫХ МАССИВОВ КРЕМНИЕВЫХ НАНОПИЛЛАРОВ», Институт Физики Полупроводников СО РАН, Новосибирск
- C2-21** **Баталов Р.И.**, Баязитов Р.М., Файзрахманов И.А., Лядов Н.М., Ивлев Г.Д. «ФОРМИРОВАНИЕ ФОТОПРИЕМНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ И ВАКУУМНО-ОСАЖДЕННЫХ СЛОЕВ Si, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ Ag», Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН», Казань
- C2-22** **Терещенко А.Н.**, Штейнман Э.А., Коплак О.В., Моргунов Р.Б. «ОСОБЕННОСТИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В КРЕМНИИ, ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ  $^{29}\text{Si}$ », ИФТТ РАН, Черногоровка
- C2-23** **Арзуманян Г.В.**, Колпачев А.Б., Чилингарова Н.С. «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АТОМАМИ ЗАМЕЩЕНИЯ ТИТАНА», Южный федеральный университет, Таганрог, Ростов-на-Дону
- C2-24** **Щукин В.Г.**, Константинов В.О., Шарафутдинов Р.Г. «СВОЙСТВА ПЛЕНОК КРЕМНИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ БОРОМ И ФОСФОРОМ, ПОЛУЧЕННЫХ ГАЗОСТРУЙНЫМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ

МЕТОДОМ», *Институт Теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск*

- C2-25** Наумова О.В., Фомин Б.И., Пинигина Д.В. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ НА ПОВЕХНОСТИ КНИ-СЕНСОРОВ», *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск*
- C2-26** Коплак О.В., Терещенко А.Н., Моргунов Р.Б. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИН-ЗАВИСИМЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ В КВАНТОВОМ КОМПЬЮТИНГЕ», *ИПХФ РАН, Черноголовка*
- C2-27** Владимирова В.М., Матвеев С.В., Марков В.В., Сергей М.Е., Шепов В.Н. «МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ «РОМЕТР» И ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА «ТАУМЕТР-2М» В КРЕМНИИ», *ООО НПФ "Электрон", Красноярск*